

24636

출력 일자: 2003/11/3

발송번호 : 9-5-2003-043659208

발송일자 : 2003.11.01

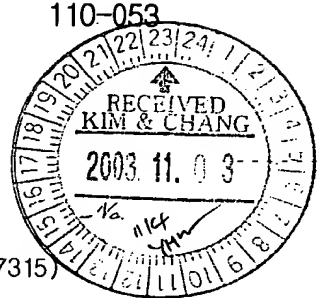
제출기일 : 2004.01.01

수신 : 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&

장 특허법률사무소)

장수길 귀하

## 특허청 의견제출통지서



출원인 명칭 가부시킴가이샤 히타치세이사쿠쇼 (출원인코드: 519987107315)

주소 일본 도쿄도 치요다구 간다스루가다이 4쵸메 6반치

대리인 성명 장수길 외 1 명

주소 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&장 특허법률사무소)

출원번호 10-2001-0052376

발명의 명칭 액티브 매트릭스형 표시 장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인 통지는 하지 않습니다.)

### [이유]

이 출원의 특허청구범위 제1-13항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

### [아래]

1. 본원 발명의 청구범위 제1-13항은 게이트전극, 게이트 절연막, 반도체층, 드레인전극, 소스전극 및 보호 절연막을 순차 적층하고, 상기 보호 절연막층의 반도체층 표면이 다공질인 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 표시장치와 박막트랜지스터의 제조 방법에 관한 것으로, 이는 한국등록특허공보 0216940호(1999.09

.01 이하 인용발명1이라 함)의 게이트전극, 게이트 절연막, 반도체층, 드레인전극, 소스전극 및 보호 절연막을 포함하고, 다공질 양극산화물 형성 공정 등에 관한 기술과 한국공개특허공보 2000-77302호(2000.12.26 이하 인용발명2라 함)의 드레인전극 및 소스전극 형성 및 반도체층 표면을 양극화성법에 의해 다공질화하는 공정 등 관련 기술내용을 본원 발명과 대비할 때 목적과 구성 및 효과가 실질적으로 동일하므로, 본원 발명은 상기 인용발명1,2로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기술적 구성의 곤란성 없이 용이하게 발명할 수 있는 것입니다(특허법 제29조제2항).

2. 본원 발명의 청구범위에는 "~이상, ~이하, ~이내" 등 상한이나 하한이 불명확한 표현으로 수치한정을 하는 등 청구범위 기재가 불명확합니다(특허법 제42조제4항제2호).

(참고사항)본원 발명의 명칭이 청구범위에서 청구한 내용에 근거할 때 부적합하게 기재되어 있습니다.

### [첨부]

첨부 1 한국등록특허공보 0216940호(1999.09.01) 1부

첨부2 한국공개특허공보 2000-77302호(2000.12.26) 1부 끝.

출력 일자: 2003/11/3

2003. 11. 01

특허청

심사4국

영상기기심사담당관실

심사관 임동재



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5759 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))내 부조리신고센터

T.JY491

Mailing date

発送日付：2003.11.01

提出期限：2004.01.01

Due date :

PATENT OFFICE

特 許 庁

意見提出通知書

OFFICE ACTION

出 願 人 氏 名 株式会社日立製作所 HITACHI, LTD.  
APPLICANT 住 所 日本国東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地

代 理 人 氏 名 張 秀 吉 外 1 人  
住 所 ソウル市鍾路区内資洞 219 ハンヌリビル  
(金&張特許法律事務所)

Application No.

出願番号 10-2001-0052376

発明の名称 アクティブマトリクス型表示装置

本出願に対する審査結果、以下のような拒絶理由があり特許法第 63 条の規定によりこれを通知するので、意見があるか補正を行う必要がある場合は、上記期限までに意見書〔特許法施行規則別紙第 25 号の 2 書式〕又は／及び補正書〔特許法施行規則別紙第 5 号書式〕を提出されたい(上記期限について毎回 1 ヶ月単位で延長を申請することができ、この申請について別途の期間延長承認通知はしない)。

[理 由]

本出願の特許請求の範囲第 1～13 項に記載された発明は、その出願前にこの発明が属する技術分野において、通常の知識を有する者が下記に指摘されたものにより容易に発明できたものと認められるので、特許法第 29 条第 2 項の規定に該当し特許を受けることができない。

本出願は、特許請求の範囲の記載が下記に指摘されている通り不備なものと認められ、特許法第 42 条第 4 項第 2 号の規定による要件を満たしていないので、特許を受けることができない。

[記]

1. 本願発明の請求範囲第 1～13 は、ゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体層、ドレイン電極、ソース電極及び保護絶縁膜を順次積層し、上記保護絶縁膜層の半導体層の表面が多孔質であることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置と薄膜トランジスタの製造方法に関するもので、これは韓国登録特許公報 0216940 号 (1999.09.01 以下、引用発明 1 という) のゲート電極、ゲート絶縁

膜、半導体層、ドレイン電極、ソース電極及び保護絶縁膜を含み、多孔質陽極酸化物形成工程等に関する技術と韓国公開特許公報 2000-77302 号 (2000.12.26 以下、引用発明 2 という) のドレイン電極及びソース電極の形成及び半導体層の表面を両極化成法により、多孔質化する工程等の関連技術内容を本願発明と比べてみると、目的と構成及び効果が実質的に同一であるので、本願発明は、上記引用発明 1,2 からこの発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が技術的構成の困難性なしに容易に発明できたものである (特許法第 29 条第 2 項)。

2. 本願発明の請求範囲においては、“～以上、～以下、～以内”等の上限又は下限が不明確な表現で数値限定する等、請求範囲の記載が不明確である (特許法第 42 条第 4 項第 2 号)。

(参考事項) 本願発明の名称が請求範囲で請求した内容に基づくとき、不適切に記載されている。

[添付] Korean Patent No.

添付 1 韓国登録特許公報 0216940 号 (1999.09.01) 1 部 = JP-A-7-135323

添付 2 韓国公開特許公報 2000-77302 号 (2000.12.26) 1 部 = JP-A-2000-32086  
KR-A

2003 年 11 月 01 日

特 許 庁

審査 4 局

映像機器審査担当官室

審査官

イム

ドン ゼ